

2N1926

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

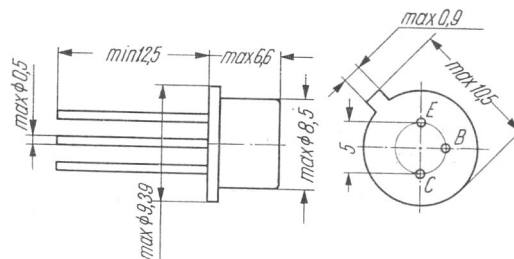
Firma: SESCOSEM

Wykonanie: tranzystor germanowy *p-n-p* w obudowie metalowej TO-39, baza połączona z obudową

Zastosowanie: wzmacniacze m.cz. małych sygnałów, wolne układy przełączające

Typy podobne: ASY77 (Ph)

Rys. 1-1147. 2N1926



Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
I_{CBO}		-5	-10	μA	przy $I_E = 0$, $U_{CB} = -45 V$
I_{EBO}		-4	-10	μA	przy $I_C = 0$, $U_{EB} = -25 V$
$U_{(BR)CBO}$	-60			V	przy $I_E = 0$, $I_C = -0,2 mA$
$U_{(BR)CEX}$	-50			V	przy $U_{BE} = 1,5 V$, $I_C = -50 \mu A$ $R_{BE} = 10 k\Omega$
$U_{(BR)CER}$	-40			V	przy $R_{BE} = 10 k\Omega$, $I_C = -0,6 mA$
U_{pt}	-50			V	
h_{21E}	72		121		przy $I_C = -20 mA$, $U_{CE} = -1 V$
h_{21E}	65	80			przy $I_C = -100 mA$, $U_{CE} = -1 V$
U_{BE}	0,18		0,28	V	przy $I_C = -20 mA$, $U_{CE} = -1 V$
U_{CEsat}	-0,06		-0,11	V	przy $I_C = -20 mA$, $I_B = -0,67 mA$
h_{21e}	60		120		przy $I_C = -1 mA$, $U_{CE} = -5 V$, $f = 1 kHz$
h_{11e}	1,5		4,2	$k\Omega$	przy $I_C = -1 mA$, $U_{CE} = -5 V$, $f = 1 kHz$
h_{12e}	4		10	10^{-4}	przy $I_C = -1 mA$, $U_{CE} = -5 V$, $f = 1 kHz$
h_{22e}	25		70	μS	przy $I_C = -1 mA$, $U_{CE} = -5 V$, $f = 1 kHz$
f_{h21b}	1,5	3		MHz	przy $I_E = 1 mA$, $U_{CB} = -5 V$
C_{22b}			30	pF	przy $U_{CB} = -5 V$, $I_E = 1 mA$, $f = 1 MHz$

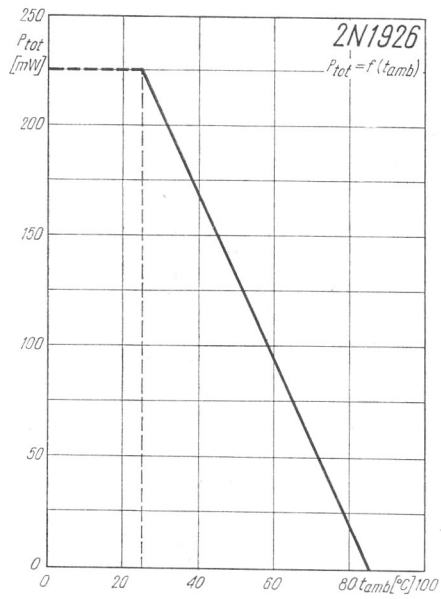
Wartości graniczne¹⁾

$U_{CBO} \max$	-60	V	$I_C \max$	-0,5	A
$U_{CEX} \max$	-50 ²⁾	V	$P_{tot} \max$	225	mW
$U_{CER} \max$	-40 ³⁾	V	$t_j \max$	85	$^{\circ}C$
$U_{EBO} \max$	-25	V	t_{stg}	-65 ÷ +100	$^{\circ}C$

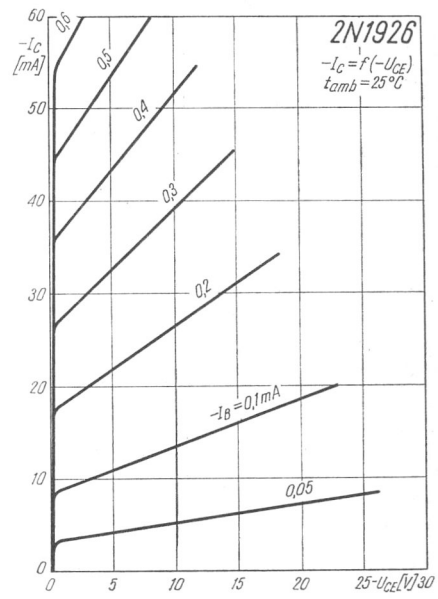
¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}C$

²⁾ $U_{BE} = 1,5 V$

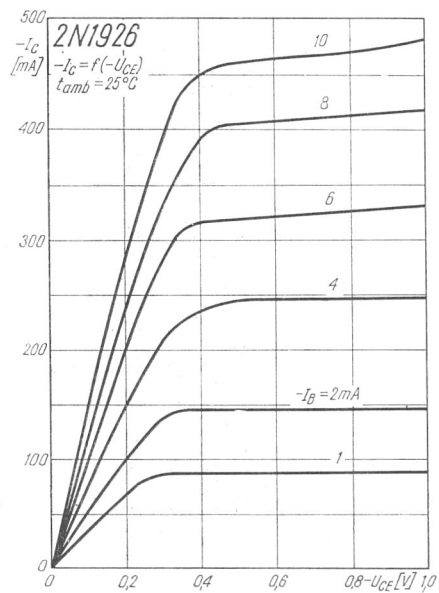
³⁾ $R_{BE} = 10 k\Omega$



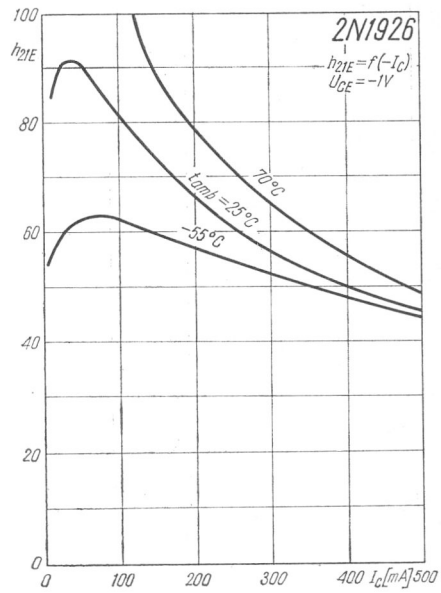
Rys. 1-1148. Zależność całkowitej mocy strat od temperatury otoczenia



Rys. 1-1149. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-1150. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-1151. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora

